

Ⅱ-4. 半導体製造装置・試験装置、マスク・レチクル 及び半導体プロセス材料

Ⅱ-4-1 様式選択ガイド

(1/2)

利用に際しては関係法令を熟知の上、下記の項目に対応する適切な様式を選択してください。

種類	関係省令番号	パラメータシート	[前版からの変更有無(参考)]※			
			2024.2.1版	2024.9.8版	2025.5.28版	
<半導体製造装置・試験装置及びマスク・レチクル>						
結晶のエピタキシャル成長装置又はその部分品若しくは附属品	第6条 第十七号	イ(一)~(四)	6-17-1/イ	無	無	有
イオン注入装置又はその部分品若しくは附属品		ロ(一)~(五)	6-17-2/ロ	無	無	無
マルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置		ホ(一)、(二)	6-17-5/ホ	無	無	無
リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品		ヘ(一)~(三)	6-17-6/ヘアエテ	無	有	有
半導体試験装置又はその部分品若しくは附属品		又(一)~(三)	6-17-8/又	無	有	無
EUVペリクルの製造装置又はその部分品若しくは附属品		ル	6-17-9/ル	新	無	無
リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品		ヲ(一)、(二)	6-17-6/ヘアエテ	新	有	無
EUVリソグラフィ用に設計された成膜、塗布、ベーク若しくは現像装置又はその部分品若しくは附属品		ワ	6-17-10/ワ	新	無	無
ドライエッチング用に設計した装置又はその部分品若しくは附属品		カ(一)、(二)	6-17-11/カ	新	無	有
ウェットエッチング装置又はその部分品若しくは附属品		ヨ	6-17-12/ヨ	新	有	無
異方性エッチング用に設計した装置又はその部分品若しくは附属品		タ(一)、(二)	6-17-13/タ	新	有	有
成膜装置又はその部分品若しくは附属品		レ(一)~(十)	6-17-14/レツネキ	新	有	有
		ソ(一)、(二)	6-17-14/レツネキ	新	無	有
		ツ(一)、(二)	6-17-14/レツネキ	新	無	有
		ネ	6-17-14/レツネキ	新	無	無
プラズマを用いたウエハーを回転させ、原子レベルで成膜する装置又はその部分品若しくは附属品		ナ(一)~(三)	6-17-18/ナ	新	無	(有)
シリコン及び炭素を含む膜の成膜装置又はその部分品若しくは附属品		ラ(一)、(二)	6-17-19/ラ	新	有	有
EUVマスク用の多層反射膜の成膜装置又はその部分品若しくは附属品		ム	6-17-20/ム	新	無	無
シリコン若しくはシリコンゲルマニウムのエピタキシャル成長装置又はその部分品若しくは附属品		ウ(一)、(二)	6-17-21/ウ	新	無	有
プラズマを用いた化学的気相成長法によりカーボンハードマスクを成膜するように設計した装置又はその部分品若しくは附属品		キ	6-17-22/キ	新	有	有
タンゲステン膜のプラズマ成膜装置又はその部分品若しくは附属品		ノ	6-17-23/ノ	新	無	無
金属配線間を埋めるプラズマ成膜装置又はその部分品若しくは附属品		オ	6-17-24/オ	新	有	有
アニール装置又はその部分品若しくは附属品		ク	6-17-25/ク	新	無	無
洗浄除去装置又はその部分品若しくは附属品		ヤ	6-17-26/ヤ	新	有	無
ドライプロセスにより前処理として表面の不純物の除去を行う洗浄除去装置又はその部分品若しくは附属品		マ	6-17-27/マ	新	有	無
乾燥を行う工程を有する枚葉式のウェット洗浄装置又はその部分品若しくは附属品	ケ	6-17-28/ケ	新	無	無	
EUVマスクブランク若しくはパターン付きEUVマスクの検査装置又はその部分品若しくは附属品	フ	6-17-29/フ	新	無	無	
プラズマドーピング用に設計されたイオン注入装置又はその部分品若しくは附属品	コ(一)~(三)	6-17-30/コ	-	-	新	
リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品	エ(一)、(二)	6-17-6/ヘアエテ	-	-	新	
リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品	テ	6-17-6/ヘアエテ	-	-	新	
エッチング装置又はその部分品若しくは附属品	ア(一)~(三)	6-17-33/ア	-	-	新	
EUVパターンシェイピング装置又はその部分品若しくは附属品	サ	6-17-34/サ	-	-	新	
成膜装置又はその部分品若しくは附属品	キ(一)~(五)	6-17-14/レツネキ	-	-	新	
アニール装置又はその部分品若しくは附属品	ユ	6-17-36/ユ	-	-	新	
超臨界二酸化炭素又は昇華乾燥を用いるウエハー洗浄装置又はその部分品若しくは附属品	メ	6-17-37/メ	-	-	新	
パターン付きウエハー欠陥測定装置又はパターン付きウエハー欠陥検査装置又はその部分品若しくは附属品	ミ(一)、(二)	6-17-38/ミ	-	-	新	
重ね合わせ誤差計測装置又はその部分品若しくは附属品	シ(一)、(二)	6-17-39/シ	-	-	新	
半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微鏡	第十七号の二	イ(一)~(七)	6-17の2/イ	-	-	新
極低温ウエハープローバ装置		ロ(一)~(二)	6-17の2/ロ	-	-	新
その他の(半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の)製造装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品			6-17-MSC	有	有	有